






	<p><b>SIR688DP-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIR688DP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 60A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.SIR688DP-T1-GE3.pdf</a> <a href="#">2.SIR688DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2625 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIR688DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2625 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.7V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3105pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIR688DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR688DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR688DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIR688DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIR680DP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 100A POWERPAKSO</p>	 <p><b>SIR692DP-T1-RE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 250V 24.2A SO8</p>	 <p><b>SIR680DP-T1-RE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 80V 100A SO8</p>	 <p><b>SIR690DP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 34.4A SO-8</p>
 <p><b>SIR670DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR690DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 34.4A SO-8</p>	 <p><b>SIR670DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR690DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 34.4A SO8</p>

### SIR688DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

SIR688DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIR688DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR688DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR688DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIR688DP-T1-GE3
SIR688DP-T1-GE3 Electronic	SIR688DP-T1-GE3-Komponenten	SIR688DP-T1-GE3-Verteiler	SIR688DP-T1-GE3-Bild	SIR688DP-T1-GE3-Teil
SIR688DP-T1-GE3 Preis	SIR688DP-T1-GE3 Hersteller	SIR688DP-T1-GE3 Bild	SIR688DP-T1-GE3 Aktie	SIR688DP-T1-GE3 Inventar
SIR688DP-T1-GE3 Neu	SIR688DP-T1-GE3 Original	SIR688DP-T1-GE3 garantiert	SIR688DP-T1-GE3 RFQ	SIR688DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited